

VXシリーズ パワーMOSFET

VX Series Power MOSFET

高速スイッチング
N-チャネル、エンハンスメント型

2SK1250

[F20W50]

500V 20A

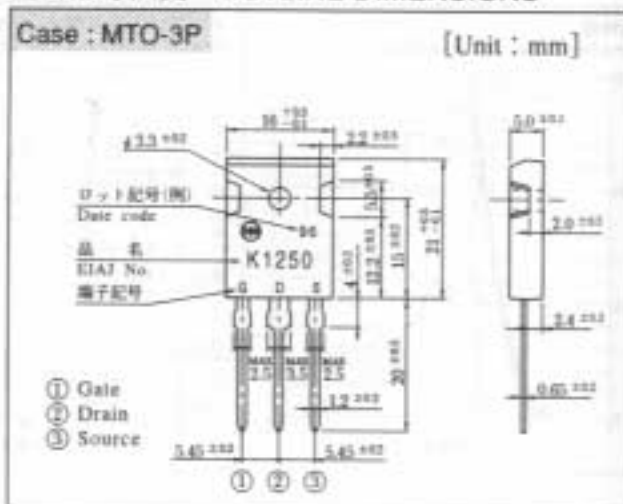
特長

- 入力容量 (Ciss) が小さい。
特にゼロバイアス時の入力容量が小さい。
- オン抵抗が小さい。
- スイッチングタイムが速い。

用途

- AC100V系入力スイッチング電源
- スイッチング方式の高圧電源
- インバータ

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	℃
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	℃
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V _{DS}		500	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V _{GS}		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	20	A
	Peak	I _{Dp}	60	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		20	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _c =25℃	150	W
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 5kg・cm) (Recommended torque : 5kg・cm)	8	kg・cm

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c=25℃)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR) DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	500			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =500V, V _{GS} =0V			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =10A, V _{DS} =10V	6	10		S
ドレイン・ソースオン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(on)}	I _D =10A, V _{GS} =10V		0.27	0.35	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =1mA, V _{DS} =10V	2	3	4	V
ソース・ドレイン順バイオード電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =10A, V _{GS} =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{JC}	接合部・ケース間 junction and case			0.83	℃/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristic	Q _G	V _{GS} =10V, I _D =20A, V _{DS} =400V,		69		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}			2,500		pF
逆伝送容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		170		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			640		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =10A, V _{GS} =10V, R _L =15Ω		130	280	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			260	500	

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

